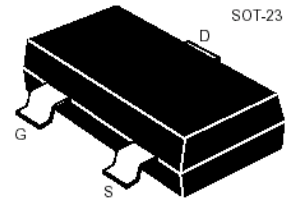




BSS138

SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)



**N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs**

**N 沟道增强型 MOS 场效应管**

**■MAXIMUM RATINGS 最大額定值**

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	$BV_{DSS}$	50	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	$V_{GS}$	$\pm 20$	V
Drain Current (continuous) 漏極電流-連續	$I_{DR}$	220	mA
Drain Current (pulsed) 漏極電流-脉冲	$I_{DRM}$	880	mA

**■THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性**

Characteristic 特性	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 $25^\circ\text{C}$ Derate above $25^\circ\text{C}$ 超過 $25^\circ\text{C}$ 遞減	$P_D$	225 1.8	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	350	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	$T_J, T_{stg}$	150 $^\circ\text{C}$ , -55to+150 $^\circ\text{C}$	

BSS138

**■DEVICE MARKING 打標**
**BSS138-SS**
**■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性**

 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓( $I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	$BV_{DSS}$	50	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓( $I_D=1\text{mA}, V_{GS}=V_{DS}$ )	$V_{GS(th)}$	0.8	—	1.6	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降( $I_{SD}=220\text{mA}, V_{GS}=0\text{V}$ )	$V_{SD}$	—	—	1.4	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=BV_{DSS}$ ) ( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=0.6BV_{DSS}$ )	$I_{DSS}$	—	—	0.5 100	$\mu\text{A}$ $\text{nA}$
Gate Body Leakage 柵極漏電流( $V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$ )	$I_{GSS}$	—	—	$\pm 100$	$\text{nA}$
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻( $I_D=220\text{mA}, V_{GS}=10\text{V}$ ) ( $I_D=220\text{mA}, V_{GS}=4.5\text{V}$ )	$R_{DS(ON)}$	—	—	3.5 6	$\Omega$
Input Capacitance 輸入電容 ( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{ISS}$	—	—	50	$\text{pF}$
Common Source Output Capacitance 共源輸出電容( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{OSS}$	—	—	25	$\text{pF}$
Turn-ON Time 開啓時間 ( $V_{DS}=30\text{V}, I_D=200\text{mA}, R_{GEN}=25\Omega$ )	$t_{(on)}$	—	—	20	ns
Turn-OFF Time 關斷時間 ( $V_{DS}=30\text{V}, I_D=200\text{mA}, R_{GEN}=25\Omega$ )	$t_{(off)}$	—	—	20	ns

- FR-5=1.0×0.75×0.062in.
- Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.
- Pulse Width≤300  $\mu\text{s}$ ; Duty Cycle≤2.0%.



**宇芯微**  
YSMICRO

**东莞市宇芯电子有限公司**

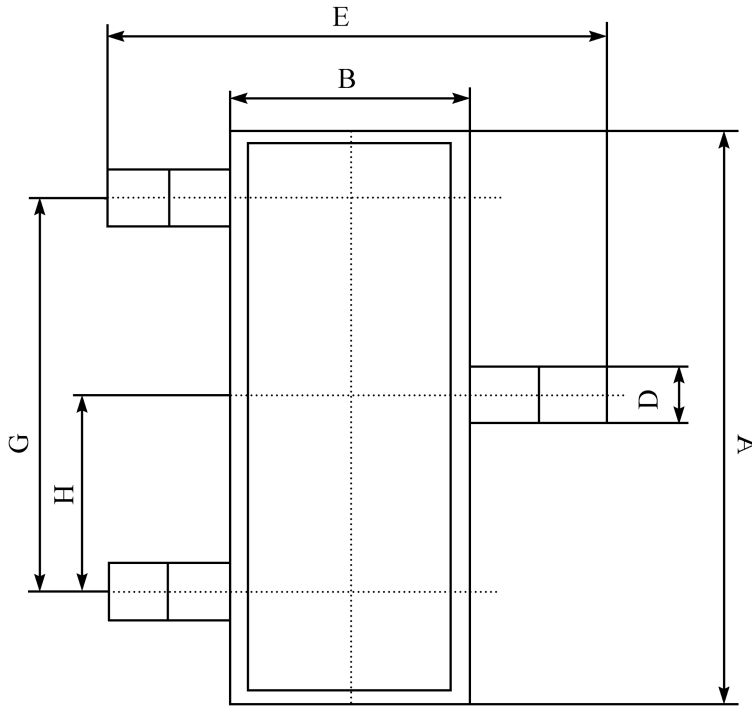
DONGGUAN YUSHIN ELECTRONICS CO.,LTD  
电话: 0769-89268116 传真: 0769-89268117

**BSS138**

BSS138

**■DIMENSION 外形封装尺寸**

單位(UNIT): mm



序號	數值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.2
N	0.60±0.10
P	7±2°

